

FN- DIALOG(R)File 347:JAPIO|

CZ- (c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.|

TI- MULTIPLEX QUANTUM WELL STRUCTURE SEMICONDUCTOR LIGHT- EMITTING ELEMENT

PN- 2000-208875 -JN 2000208875 A-

PD- July 28, 2000 (20000728)

AU- DOUMEN MEGUMI

PA- FUJITSU LTD

AN- 11-007156 -JP 997156-

AN- 11-007156 -JP 997156-

AD- January 14, 1999 (19990114)

H01S-005/343; H01L-033/00

AB- PROBLEM TO BE SOLVED: To improve hole implantation efficiency and evenness in hole distribution by allowing a p-type impurity concentration of a barrier layer constituting a multiplex quantum well active layer to be a specific value or above. SOLUTION: The impurity concentration of a barrier layer 3 constituting a multiplex quantum well(MQW) active layer 1 is doped with such a high concentration as  $5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  to  $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  or above that a carrier concentration saturates. Thus, carrier implantation efficiency is improved with a transmission mechanism which is different from a conventional one, eliminating uneven implantation of carrier. A p-type optical guide layer 4 is allowed to be such a heavily doped layer as  $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  or above so that hopping transmission or tunneling transmission takes place even at the p-type optical guide layer 4, and a notch which is an electric-potential barrier to a hole is hopping- transmitted or tunnel-transmitted through an impurity level so that a hole is efficiently implanted. COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開 2000-208875

(P 2000-208875A)

(33) 公開日 平成12年7月28日 (2000.7.28)

(51) Int. C.I.  
1101S  
// H01L

識別記号

5/343  
33/00

F I

1101S  
H01L

3/18  
33/00

6 7 7

5F041  
C

テ-ワード (参考)  
5F073

審査請求 未請求 請求項の数 5

O L

(全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平11-7156

(71) 山岡人 000005223

富士通株式会社

(22) 出願日 平成11年1月14日 (1999.1.14)

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

(72) 発明者 堂光 忠

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

(74) 代理人 100072833

弁理士 柏谷 朝司 (外2名)

F ターム (参考) 5F041 AA03 CA04 CA05 CA33 CA34  
CA40 CA65 FP16  
5F073 AA45 AA51 AA74 BA06 CA07  
CB04 CB19 DA05 EA23

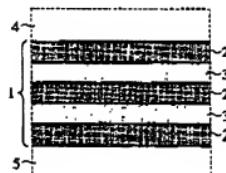
(54) 【発明の名称】多重量子井戸構造半導体発光素子

(57) 【要約】

【課題】 多重量子井戸構造半導体発光素子に関し、多重量子井戸活性層の結晶性に影響を与えることなく、ホールの注入効率及び多重量子井戸活性層中におけるホールの分布の均一性を改善する。

【解決手段】 ナイトライド系化合物半導体を用いた多重量子井戸構造半導体発光素子の多重量子井戸活性層1を構成する複数層3のp型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とする。

本発明の原理的構成の説明図



1: 多重量子井戸活性層

2: 井戸層

3: 障壁層

4: p側光ガイド層

5: n側光ガイド層

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 多重量子井戸活性層を構成する隣接層の p 型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  以上とすることを特徴とするナイトライド系化合物半導体を用いた多重量子井戸構造半導体発光素子。

【請求項 2】 多重量子井戸活性層の p 側に設ける p 側光ガイド層の少なくとも一部の p 型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  以上とすることを特徴とするナイトライド系化合物半導体を用いた多重量子井戸構造半導体発光素子。

【請求項 3】 上記多重量子井戸活性層を構成する井戸層を、アンドープ層とすることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の多重量子井戸構造半導体発光素子。

【請求項 4】 上記多重量子井戸活性層と上記 p 側光ガイド層との間に p 型エレクトロンブロック層を設けるとともに、p 型エレクトロンブロック層の p 型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  以上とすることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の多重量子井戸構造半導体発光素子。

【請求項 5】 上記 p 型不純物として、Mg を用いたことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の多重量子井戸構造半導体発光素子。

## 【発明の詳細な説明】

## 【00001】

【発明の属する技術分野】 本発明は多重量子井戸構造半導体発光素子に関するものであり、特に、ナイトライド系化合物半導体からなる短波長半導体レーザーにおける正孔の不均一注入を改善するための多重量子井戸構造及びその近傍の層の不純物濃度に特徴がある多重量子井戸構造半導体発光素子に関するものである。

## 【00002】

【従来の技術】 従来、短波長半導体レーザーは、光ディスクや DVD 等の光頭として用いられているが、光ディスクの記録密度はレーザー光の波長の<sup>2</sup>乗に反比例するため、より短い波長の半導体レーザーが要請されており、現在商品化されている最短波長の半導体レーザーは 630 ~ 650 nm 近傍に波長を有する赤色半導体レーザーであり、一昨年発売された DVD に用いられている。

【00003】 しかし、より記録密度を高めるためにはさらなる短波長化が必要であり、例えば、光ディスクに動画を 2 時間記録するために波長が 400 nm 近傍の青色半導体レーザーが不可欠となり、そのため、近年では次世代光ディスク用光頭として、青色領域に波長を有する短波長半導体レーザーの開発が盛んになされている。

【00004】 この様な青色半導体レーザー用材料としては、GaN 系化合物半導体が注目されており、特に、1993 年秋の日亜化学による GaN 高純度 LED の発表を機に、ZnS-C 系でネックになっている信頼性に関して耐環境性に優れる GaN が見直され、世界中で研究者の大きな増加を見ている。

【00005】 次いで、1995 年 12 月初めには、同じく日亜化学によりバルスレーザー発振の成功が報告されて以来、急速に研究が進み、現存、実験連続発振 (CW 発振) において、7000 時間の発振持続時間が報告されている。

【00006】 この様な從来の短波長半導体レーザーは、例えば、(00001) 面を正面とするサファイア基板上に、低温 GaN バッファ層を介して、n 型 GaN バッファ層、n 型 In<sub>x</sub>GaN 層、n 型 Al<sub>y</sub>In<sub>1-y</sub>GaN 層、n 型 GaN クラッド層、n 型 Al<sub>1-x</sub>GaN<sub>x</sub>N 層、p 型 GaN 光ガイド層、p 型 Al<sub>1-x</sub>GaN<sub>x</sub>N クラッド層、及び、p 型 GaN コンタクト層を MOVPE 法 (有機金属気相成長法) によって順次エピタキシャル成長させたのち、ドライ・エッチングにより n 型 GaN バッファ層の一部を露出させて、Ti/Au からなる n 側電極を設けると共に、p 型 GaN コンタクト層上には Ni/Au からなる p 側電極を設け、次いで、ドライ・エッチングを施して共振器面となる一対の平行な端面を形成するものであり、この様な構成によってバルスレーザー発振に成功している (必要なならば、S. Nakamura et al., Japanese Journal of Applied Physics, vol. 35, p. L74, 1996 参照)。

【00007】 しかし、この様なサファイア基板を用いた MQW 構造短波長半導体レーザーの場合、しきい値電流密度 J<sub>c</sub> が 3, 6 kA/cm<sup>2</sup> 程度と、非常に大きいという問題があり、これは基板のサファイアに弱酸性がないことが原因となる。

【00008】 そこで、木山顕人等は、基板として劈開性を有し、且つ、結晶構造が似ている SiC 基板を用いてナイトライド系 MQW 構造半導体レーザーを構成することによってレーザー発振に成功しているので、ここで、図 4 を参照して、この様な從来の MQW 半導体レーザーを説明する。なお、図 4 (a) は、木山顕人による従来の MQW 半導体レーザーの概略的な斜視図であり、また、図 4 (b) は図 4 (a) において破線の円で示す MQW 活性層近傍の層構造を模式的に示す拡大図である。

## 図 4 (a) 参照

まず、(00001) 面、即ち、c 面を正面とする六方晶の 6H-SiC からなる n 型 SiC 基板 31 に、有機金属気相成長法 (MOVPE 法) を用いて、n 型 Al<sub>1-y</sub>G<sub>y</sub>N バッファ層 32、n 型 GaN 中間層 33、n 型 Al<sub>1-y</sub>In<sub>y</sub>GaN<sub>x</sub>N クラッド層 34、アンドープ GaN 光ガイド層 35、MQW 活性層 36、アンドープ GaN 光ガイド層 39、p 型 Al<sub>1-x</sub>G<sub>x</sub>N<sub>y</sub> クラッド層 40、及び、p 型 GaN コンタクト層 41 を順次成長させる。

## 【00009】 図 4 (b) 参照

なお、この場合の MQW 活性層 36 は、厚さが、例えば、3 nm のアンドープ In<sub>0.05</sub>G<sub>0.95</sub>N パリア層 3

8で分離された厚さが、例えば、4 nmのアンドープ $\text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ ウェル層37を、例えば、5層成長させて形成する。

【0010】次いで、n型SiC基板31の裏面にはn側電極として厚さN1電極42を設けると共に、p型GaNコンタクト層41上にはp側電極として幅Wが3 μmのN1電極43を設け、共振器長しが700 μmとなるように赤外分光器によってMQW半導体レーザーが完成する。

【0011】しかし、この様にSiC基板を用いたMQW半導体レーザーにおいても、依然としてしきい値電流密度J<sub>s</sub>の高さは問題となる。それは、基板の導通性の問題のほかに、GaN系化合物半導体、即ち、ナイトライド系化合物半導体という材料が、光学利得を発生するためには、本質的に大きなキャリア密度を必要とするためである。

【0012】即ち、従来、実用化されている半導体レーザーは、AlGaAs系やAlInGaAs系等の閃亜鉛鉱型結晶構造のIII-V族化合物半導体を用いているのに対して、ナイトライド系化合物半導体は、非常に大きな禁制帯幅を有する六方晶ウルツ鉱構造であり、閃亜鉛鉱型結晶材料とは全く異なる物性を有しているためである。

【0013】この様なナイトライド系化合物半導体の物性 $J_s$ の大きな特徴は、六方晶であり結晶に異方性が存在すること、禁制帯幅が大きく有効質量が大きいこと、スピントラロト作用が小さく、伝電子率に、HH (Heavy Hole)、LH (Light Hole)、及び、CHの3つのバンドが近接して存在することの三つが挙げられる。

【0014】この内、有効質量が大きいことが主な原因で、p側SC-H (Separate Confinement Heterostructure) 層、即ち、p側光ガイド層から活性層へのホールの注入効率が非常に悪くなり、特に、活性層が多量子井戸構造のMQW活性層である場合、ホールの注入効率の悪さは量子井戸層（ウェル層）間のホール密度の不均一を生み、レーザー発振を非効率にすることになるので、この事実を図5及び図6を参照して説明する。

#### 【0015】図5参照

図5は、MQW半導体レーザーの発振時の電子膜厚方向のホール密度分布のシミュレーション結果を示す図であり、図から明らかのように、多量子井戸活性層におけるホール密度がp側光ガイド層に近いほど大きく、不均一になっていることが理解される。

#### 【0016】図6参照

図6は、同じくMQW半導体レーザーの発振時の電子膜厚方向の電子密度分布のシミュレーション結果を示す図であり、図から明らかのように、n側光ガイド層側から注入される多量子井戸活性層における電子密度もp側光

ガイド層に向かうほど大きく不均一になっていることが理解され、これは上述のホール不均一注入が原因で、電荷中性条件を満たすために電子がホールに引き寄せられる結果である。

【0017】この様に、ホールと電子ともに同様の不均一が起きていることによって、多量子井戸構造における光学利得の発生を著しく不均一にすることが予想されるので、この事実を図7を参照して説明する。

#### 【0018】図7参照

図7は、上述のナイトライド系化合物半導体を用いたMQW半導体レーザーの多量子井戸中における光学利得分布の説明図であり、p型クラッド層側から第1番目の量子井戸においてはp型クラッド層からのホールの供給が多いため、大きな光学利得を有しているが、n型クラッド層側へ向かうにつれて光学利得は減少し、n型クラッド層側の2つの量子井戸においては光学利得を発生しないばかりか、光の損失が生じるという従来の閃亜鉛鉱型結晶構造の半導体を用いたレーザーと異なる特性となる。

【0019】この様な光学利得の量子井戸間の不均一による光吸収層の発生は、二つの悪影響を与えることになり、第一は、光吸収層となっているn側の2つの量子井戸戸においても、図5及び図6から明らかなようにキャリアが高密度に存在するため、発光内結合電流が大きいことを意味し、p側の3つの量子井戸戸がレーザー発振のしきい値フェルミレベルに達する電圧値をn側の2つの量子井戸戸が増加させる結果となる。

【0020】第二に、n側の2つの量子井戸戸が光吸収層であるために、レーザー発振するために克服すべき内部ロスが増加し、しきい値フェルミレベルそのものが昇してしまるという悪影響が生ずることになる。

#### 【0021】図8参照

図8は、多量子井戸活性層における量子井戸戸の数を変えて実際に作製したMQW半導体レーザーの光出力-電流特性を示す図であり、この場合、全体の光閉じ込めを一定にするために膜厚を変化させているが、5戸の量子井戸戸からなる活性層を設けたMQW半導体レーザーの方が3戸の量子井戸戸からなる活性層を設けたMQW半導体レーザーの場合よりしきい値電流密度J<sub>s</sub>が高く、且つ、レーザー発振後の効率も悪いことがわかる。

【0022】これは、半導体レーザーの効率は内部量子効率と内部ロスで決定されるため、n側の2つの量子井戸戸が光吸収層になっていることによって、内部量子効率及び内部ロスの両者が劣化していることが原因であると考えられ、したがって、ナイトライド系化合物半導体を用いたMQW半導体レーザーの特性を改善するためには、しきい値電流密度J<sub>s</sub>を低減せねばならないことが必要になるが、そのためには、上述のキャリアの不均一注入を改善することが有効となる。

【0023】そこで、木山頼人は、AlGaNエレクトロニンブロック戸をp型不純物により高濃度ドープするこ

とによってキャリアのオーバーフローが効果的に抑制できることを実験的に見出している。この理由は必ずしも明らかではないが、エレクトロンブロック層の偏電子帯側に深い不純物単位が高濃度に形成され、この不純物単位を介した不純物伝導(hopping conduction)によって、ホールが効率的に活性層に注入されるため、結果的にキャリアのオーバーフローが抑制されると考えられる（必要ならば、特開平10-215147号参照）。この様に、歴史となる層へのp型不純物の高濃度ドープによって、ホールの注入効率を改善することができるものと考えられる。

**[0024]** 一般に、GaNのキャリア濃度は、600～900°Cの比較的低速成長においては、不純物濃度が約 $5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 近傍で最大の約 $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ になるにも拘らず、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上、例えば、 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ にすることによって、しきい値電流密度 $J_{\text{th}}$ が改善されているので、この場合の伝導機構は四重結合型結晶構造の従来材料とは全く異なるものであると考えられる。

**[0025]** 即ち、GaNよりさらにドーピングが困難なAlGaNにおいては $10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 程度のホール濃度しか得られないが、上述のようにp型不純物を $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上に高濃度ドーピングを行うことによって、禁制帶中に多孔のアカゼタ型不純物単位を導入し、ホッピング伝導或いはトンネリング伝導によってホールの伝導が容易になるものと考えられる。

#### [0026]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述の様なエレクトロンブロック層を始めとするp側のAlGaN層の不純物濃度を高めるだけではホールの注入効率は改善されるものの、MQW活性層内におけるキャリアの不均一分布の改善は必ずしも十分ではなく、さらなる改善の余地があると考えられる。

**[0027]** そこで、検討するに、一般に、MQW半導体レーザにおけるキャリアの不均一注入を改善するためには、多重量子井戸構造におけるウエル層の膜厚を薄くすること、パリア層の厚さを薄くすること、及び、パリア層の高さを低く、即ち、禁制帶幅を小さくすることが有効であると考えられる。

**[0028]** この内、ウエル層の膜厚は、レーザの光学利得特性を大きく左右し、レーザ設計の最重要項目であるため、独立に変化させることは難しいという問題があり、また、ナイトライド系MQW青色半導体レーザにおいて、パリア層の禁制帶幅を小さくするということは、パリア層中のn網成を増加することを意味することになるが、これは穴の増加をもたらし、結晶性が劣化することになるので好ましくない。

**[0029]** 一方、パリア層の膜厚については、ナイトライド系化合物半導体を用いたMQW半導体レーザにおいては、上述のようにキャリアの有効質量が大きいため、量子井戸からの波動関数の漏み出ししが少なく、且つ、バンド・ギャップの不均一性のため段階状の光学利得分布がもともと若干なっているため、パリア層の膜厚を薄くすることが最善の手段であると考えられているが、InGaNパリア層を薄くすると、InGaN層の成長は下地依存性等があるため、InGaNパリア層成りはInGaNウエル層の膜厚の不均一化をもたらし、MQW活性層自体の結晶性を微かに変化させる虞がある。

**[0030]** なお、しきい値電流密度 $J_{\text{th}}$ 低下させるために、

① MQW活性層を構成するウエル層及びパリア層の少なからずとも一方をn型不純物によって、 $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ にドープすること、或いは、

② ウエル層にZnを $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ 、例えば、 $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ にドープし、パリア層をノン・ドープにすること、或いは、

③ ウエル層にSiを $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ とZnを $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ドープし、パリア層をノン・ドープにすることが提案されている（必要ならば、特開平10-12969号公報参照）。

**[0031]** しかし、上記の提案における①の構成の場合には、n型不純物を高濃度でドープしたものであるのでホールの伝導及び分布に直接寄与するものではなく、且つ、①～③の場合には、再結合発光の行われるウエル層を高不純物濃度にしているので、再結合発光の行われるウエル層の結晶性の劣化が問題となり、さらに、上記提案においては、ホッピング伝導或いはトンネリング伝導に関する認識は全くなく、仮に、Znの高濃度ドープによりホールのホッピング伝導或いはトンネリング伝導が生じていたとしても、それは、ウエル層においてであり、ホールに対する電位障壁となるパリア層においてではないので、ホールの注入に関しては本質的には從来と同じ伝導機構であると考えられる。

**[0032]** したがって、本発明は、多重量子井戸活性層の結晶性に影響を与えることなく、ホールの注入効率及び多重量子井戸活性層中におけるホールの分布の均一性を改善することを目的とする。

#### [0033]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理的構成の説明図であり、この図1を参照して本発明における課題を解決するための手段を説明する。なお、図1は多重量子井戸活性層近傍の層構造を示す図であり、図における符号5はn側光ガイド層を表す。

#### 図1参照

(1) 本発明は、ナイトライド系化合物半導体を用いた多重量子井戸構成半導体発光素子において、多重量子井戸活性層1を構成する障壁層3のp型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とすることを特徴とする。

**[0034]** この様に、多重量子井戸活性層1を構成す

る障壁層3、即ち、パリヤ層のp型不純物濃度を $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とすることによって、多重量子井戸活性層1内におけるホールの移動を容易にすることができる、それによって、多重量子井戸活性層1内におけるホールの分布を均一にし、ひいては、電子の分布も均一にすることができる。なお、この場合の多重量子井戸活性層1内におけるホールの移動もホッピング伝導あるいはトンネル伝導であると考えられ、また、高濃度ドープ層は凸結合発光が実効的に生じない障壁層3があるので、高濃度ドープに伴う多重量子井戸活性層1の結晶性はあまり問題とならない。

【0035】(2) また、本発明は、ナイトライド系化合物半導体を用いた多重量子井戸構造半導体発光素子において、多重量子井戸活性層1のp側に設けるp側光ガイド層4の少なくとも一部のp型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とすることを特徴とする。

【0036】一般に、多重量子井戸活性層1とp側光ガイド層4との接合界面、p側光ガイド層4とp側エレクトロンブロック層との接合界面、あるいは、p側光ガイド層4とp型クラッド層との接合界面には、電子親和力と禁制帯幅の差に起因するノッチが発生し、ホールの注入に対する電位障壁となるが、p側光ガイド層4、即ち、p型SCH層の少なくとも一部のp型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とすることによって、ホッピング伝導あるいはトンネリング伝導によってノッチの障壁を通過することが可能になる。

【0037】また、ナイトライド系化合物半導体においてはビエゾ効果が大きいため、各層接する層との間の歪が正縮歪／引張歪／正縮歪／引張歪／…と交互に変わるために、歪の向きの違いによってビエゾ効果による内部電界が発生し、この内部電界がバンドの曲がり・傾きに影響を与え、それが電位障壁となってホールの注入にも影響を与えると考えられるが、ホッピング伝導あるいはトンネリング伝導によってホールの移動が容易になる効果も期待できる。なお、この場合の「p側光ガイド層4の少なくとも一部」とは、p側光ガイド層4が薄ければ全体を高濃度ドーピングしても良いし、あるいは、多重量子井戸活性層1側、または、p型クラッド層側の一部を高濃度ドーピングしても良いし、成いは、多重量子井戸活性層1側またはp型クラッド層側がより高濃度になるようグレーデッドにドープしても良いことを意味する。

【0038】(3) また、本発明は、上記(1)または(2)において、多重量子井戸活性層1を構成する井戸層2を、アンドープ層とすることを特徴とする。

【0039】この様に、井結合発光の生じる多重量子井戸活性層1を構成する井戸層2をアンドープ層としているの、井戸層2自体の結晶性が劣化することがなく、したがって、多重量子井戸活性層1全体の結晶性の劣化が問題となることはない。

【0040】(4) また、本発明は、上記(1)乃至(3)のいずれかにおいて、多重量子井戸活性層1とp側光ガイド層4との間にp型エレクトロンブロック層を設けるとともに、p型エレクトロンブロック層のp型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とすることを特徴とする。

【0041】この様に、多重量子井戸活性層1とp側光ガイド層4との間にp型エレクトロンブロック層を設けた場合、p型エレクトロンブロック層のp型不純物濃度を、 $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とすることによって、p型エレクトロンブロック層自体あるいはp型エレクトロンブロック層の両側に発生するノッチはホールに対する電子障壁となってしまふので、ホッピング伝導あるいはトンネリング伝導によってホールの移動が容易になる。

【0042】(5) また、本発明は、上記(1)乃至(4)のいずれかにおいて、p型不純物として、Mgを用いたことを特徴とする。

【0043】この様に、p型不純物としてMgを用いることによって、Mg濃度を $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上とすることによって、不純物半導体によるホッピング伝導あるいはトンネリング伝導が可能になり、ホール濃度及びホールの注入効率を確実に向上することができる。

#### 【0044】

【発明の実施の形態】ここで、図2を参照して本発明の第1の実施の形態のMQW半導体レーザを説明する。なお、図2(a)は、本発明の第1の実施の形態のMQW半導体レーザの概略的な斜視図であり、また、図2(b)は図2(a)において破線の円で示すMQW活性層近傍の構造を模式的に示す拡大図である。

#### 図2(a) 及び(b) 参照

まず、(0001)面、即ち、c面を正面とする六方晶の6H-SiCからなるn型SiC基板1上に、TMGa(トリメチルガリウム)、TMAI(トリメチルアルミニウム)、アンモニア、ドーパント源としてSiH<sub>4</sub>、及び、キャリアガスとしての水素を成長ガスとして用いたMOVPE法によって、成長圧力を7.0~7.60 Torr、例えば、1.00 Torrとし、成長温度を800~1200°C、例えば、950°Cとした状態で、厚さ50~300 nm、例えば、50 nmのn型AlGaNバッファ層1'を成長させる。

【0045】引き続いて、TMGa、アンモニア、ドーパント源としてSiH<sub>4</sub>、及び、キャリアガスとして水素を用いて、成長圧力を7.0~7.60 Torr、例えば、1.00 Torrとし、成長温度を800~1200°C、例えば、920°Cとした状態で、厚さ0.1~2.0 μm、例えば、0.5 μmで、キャリア濃度が $5 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、例えば、 $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ のn型GaN中間層1'を成長させる。

【0046】引き続いて、TMAI、TMGa、アンモニア、ドーパントとしてSiH<sub>4</sub>、及び、キャリアガス

としての水素を用いて、成長圧力を70~760 Torr、例えば、100 Torrとし、成長温度を800~1200°C、例えば、950°Cとした状態で、厚さ0.1~2.0 μm、例えば、0.5 μmで、キャリア濃度が $1 \times 10^{17}$ ~ $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、例えば、 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ のn型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nクラッド層14を成長させる。

【0047】引き続いて、TMGa、アンモニア、及び、キャリアガスとしての水素を用いて、成長圧力を70~760 Torr、例えば、100 Torrとし、成長温度を800~1200°C、例えば、930°Cとした状態で、厚さ10~300 nm、例えば、100 nmのアンドープGaN光ガイド層15を成長させる。

【0048】引き続いて、TMGa、TMAI(トリメチルインジウム)、アンモニア、及び、キャリアガスとしてのN<sub>2</sub>を用いて、成長圧力を70~760 Torr、例えば、100 Torrとし、成長温度を550~900°C、例えば、700°Cとした状態で、厚さ1 nm~10 nm、例えば、5 nmのp'型In<sub>0.05</sub>Ga<sub>0.95</sub>Nバリア層18で分離された厚さ3~10 nm、例えば、4 nmのアンドープIn<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nウエル層17を2~10層、例えば、3層成長させてMQW活性層16を形成する。

【0049】このMQW活性層16の成長に際しては、ビスマクロベンタジエニルマグネシウムの供給を制御し、p'型In<sub>0.05</sub>Ga<sub>0.95</sub>Nバリア層18の不純物濃度が $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上、例えば、 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ となり、アンドープIn<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nウエル層17の成長に際しては、ビスマクロベンタジエニルマグネシウムの供給を停止し、尖端的にアンドープになるようにする必要がある。但し、アンドープIn<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nウエル層17には残留Mgが不可避的に若干取り込まれることになる。

【0050】引き続いて、TMGa、アンモニア、ビスマクロベンタジエニルマグネシウム、及び、キャリアガスとしてのN<sub>2</sub>を用いて、成長圧力を70~760 Torr、例えば、100 Torrとし、成長温度を800~1200°C、例えば、1130°Cとした状態で、厚さ10~300 nm、例えば、100 nmで、不純物濃度が $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上、例えば、 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ のp'型GaN光ガイド層19を成長させる。

【0051】引き続いて、TMAI、TMGa、アンモニア、ビスマクロベンタジエニルマグネシウム、及び、キャリアガスとしてのN<sub>2</sub>を用いて、成長圧力を70~760 Torr、例えば、100 Torrとし、成長温度を800~1200°C、例えば、950°Cとした状態で、厚さ0.1~2.0 μm、例えば、0.5 μmで、不純物濃度が $1 \times 10^{17}$ ~ $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、例えば、 $2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ のp型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nクラッド層20を成長させる。

【0052】引き続いて、TMGa、アンモニア、ビスマクロベンタジエニルマグネシウム、及び、キャリアガスとしてのN<sub>2</sub>を用いて、成長圧力を70~760 Torr、例えば、100 Torrとし、成長温度を800~1200°C、例えば、930°Cとした状態で、厚さ0.1~2.0 μm、例えば、0.5 μmで、不純物濃度が $1 \times 10^{17}$ ~ $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、例えば、 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ のp型GaNコンタクト層21を成長させる。

【0053】次いで、n型SiC基板11の裏面にはn側電極として厚さ100 nmのN<sub>1</sub>電極22を設けると共に、p型GaNコンタクト層21上にはp側電極として厚さ100 nm、幅Wが3 μmのN<sub>1</sub>電極23を設け、共振器長しが700 μmとなるように素子分割することによってMQW半導体レーザが完成する。

【0054】この本発明の第1の実施の形態においては、MQW活性層16を構成するバリア層の不純物濃度を、従来常識に反してキャリア濃度が飽和する $5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上の $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上に高濃度でドープすることによって、従来とは異なった伝導機構によりキャリアの注入効率が改善され、キャリアの不均一注入をなくすことが可能になると考えられる。

【0055】また、この第1の実施の形態においては、p側光ガイド層を $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上の高濃度ドープ層としているので、p側光ガイド層においてもホッピング伝導あるいはトンネリング伝導が生じ、電子親和力と禁制帯幅の差の差によってMQW活性層16とp'型GaN光ガイド層19との界面に形成されるホールに対する電位障壁となるノッチを、不純物分布を介したホッピング伝導あるいはトンネリング伝導することによってホールを効率的に注入することが可能になり、注入効率が改善されることになる。

【0056】また、各隣接する層との間の差が正縮波/引張波/正縮波/引張波/···と交互に変わるために、前の向きの違いによってビエゾ効果による内部電界が発生することになるが、ナイトライド系化合物半導体においてはビエゾ効果が大きいため、内部電界が $10^6 \text{ V/cm}$ 程度となり、これは、 $1 \text{ V}/100 \text{ Å}$ に相当するので、この内部電界がバンドの曲がり、傾きに影響を与えると考えられるが、ホッピング伝導あるいはトンネリング伝導によって内部電界に起因する電位障壁を越えてのホールの移動が容易になる効果も期待できる。

【0057】次に、図3を参照して、本発明の第2の実施の形態を説明する。

#### 図3参考

図3は、本発明の第2の実施の形態のMQW半導体レーザの斜視図であり、上記の第1の実施の形態との違いは、MQW活性層16とp'型GaN光ガイド層19との間に高不純物濃度のエレクトロンブロック層を設けた

点だけであるので、詳細な説明は省略する。

【0058】まず、上記の第1の実施の形態と全く同様に、c面を正面とする六方晶の $6\text{H}-\text{SiC}$ からなるn型SiC基板1上に、n型AlGaNバッファ層1、n型GaN中間層13、n型Al<sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>Nクラッド層14、アンドープGaN光ガイド層15、及び、MQW活性層16を順次堆積させる。

【0059】この場合のMQW活性層16も、バリア層を不純物濃度が $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上、例えば、 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ のp'型Al<sub>n</sub><sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>N層とし、ウエル層をアンドープAl<sub>n</sub><sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>N層とし、ウエル層が2~10層、例えば、3層になるように交互に堆積する。

【0060】引き続いて、TMAl、TMGa、アンモニア、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム、及び、キャリアガスとしてのN<sub>2</sub>を用いて、成長正力を7.0~7.60Torrとし、成長温度を600~900°Cとし、成長速度を2~10nm、例えば、20nmで、不純物濃度が $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以下、例えば、 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ のp'型Al<sub>n</sub><sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>Nエレクトロンプロック層24を成長させる。

【0061】以降は、再び、上記の第1の実施の形態と全く同様に、p'型GaN光ガイド層19、p型Al<sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>Nクラッド層20、及び、p型GaNコンタクト層21を順次成長させたのち、n型SiC基板1の表面にはn側電極として厚さ1000nmのNi電極22を設けると共に、p型GaNコンタクト層21上にはp側電極として厚さ1000nm、幅Wが3μmのNi電極23を設け、共共振器長Lが7000μmとなるように電子分割することによってMQW半導体レーザーが完成する。

【0062】この第2の実施の形態においては、MQW活性層16とp'型GaN光ガイド層19との間に不純物濃度が $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上のp'型Al<sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>Nエレクトロンプロック層24を設けているので、単に電子のオーバーフローを低減するだけでなく、本来、ホールに対する電位障壁となるエレクトロンプロック層の価電子帯側の隙歴をエレクトロンプロック層に形成された不純物準位を介したホッピング伝導あるいはトンネル伝導によって通過することによってホールの注入効率を改善することができ、MQW活性層16のバリア層を高濃度ドーピングした効果と相まってホール分布の均一性を改善することができる。

【0063】以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、本発明は上記の各実施の形態の構成に限られるものではなく、各種の変更が可能である。例えば、各実施の形態においては、MQW活性層16のバリア層及びp側光ガイド層の双方をp型不純物であるMgによって $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上にドーピングしているが、どちらか一方

のみを高濃度ドーピングするだけでも良いものである。

【0064】また、上記の各実施の形態においては、p側光ガイド層の全体を $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上に均一にドーピングしているが、必ずしもp側光ガイド層の全体を均一ドーピングする必要はない。特に、p側光ガイド層が厚い場合には、全体を高濃度のドーピングすると結晶品の劣化をもたらすことになるので、p側光ガイド層の少なくとも一部、特に、ホールに対する電位障壁となるノッチの形成されるMQW活性層16に接する側の2~50nmまたはp型Al<sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>A<sub>x</sub>クラッド層20に接する側の2~50nm、例えば、20nmを $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上、例えば、 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ にドーピングするだけでも良い。

【0065】また、この様な部分的なドーピングはグレーディッドに変化するドーピングでも良いものであり、例えば、MQW活性層16に接する側を $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上、例えば、 $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ とし、界面から離れるにしたがって減少し、p型Al<sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>Nクラッド層20との界面で、 $1.0 \times 10^{17} \sim 1.0 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 、例えば、 $2.0 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ となるようにしても良いものである。

【0066】また、上記の各実施の形態の説明においては、MQW活性層16をn層のバリア層と(n+1)層のウエル層によって構成しているが、逆に、(n+1)層のバリア層とn層のウエル層によって構成しても良いものである。

【0067】また、上記の各実施の形態においては、多重量子井戸活性層としてIn<sub>n</sub><sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>N/In<sub>n</sub><sub>0.15</sub>GaN<sub>0.85</sub>NからなるMQW構造を採用しているが、必要とする波長に応じて混晶比をAl<sub>x</sub>Ga<sub>1-x-y</sub>N(0≤x<1, 0<y≤1)の範囲内で変えてでも良いものであり、且つ、それに伴って、光ガイド層及びクラッド層の混晶比をAl<sub>1-x</sub>Ga<sub>x</sub>In<sub>y</sub>N(0≤y≤1, 0≤x≤1)の範囲内で変えてても良い。

【0068】また、上記の各実施の形態においては、MQW半導体レーザーとして説明しているが、準準体レーザーに限られるものではなく、高輝度発光短波長発光ダイオード等の他の半導体発光素子も対象とするものである。

【0069】

【発明の効果】本発明によれば、ナイトライド系化合物半導体からなる多重量子井戸構造半導体発光素子の多重量子井戸活性層を構成するバリア層成いはp側光ガイド層の少なくとも一方のp型不純物濃度を、従来常識によして $7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 以上としているので、従来と異なる長波長機能によってホールの不均一注入を改善し、光学利得の不均一な発生を改善することができる。それによって、しきい値電流密度J<sub>c</sub>が低減され、低消費電力化が可能になり、また、信頼性が向上するので、光情報記録装置等の光源としてその高密度化に寄与するところが大きい。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理的構成の説明図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態のMQW半導体レーザの説明図である。

【図3】本発明の第2の実施の形態のMQW半導体レーザの斜視図である。

【図4】従来のMQW半導体レーザの説明図である。

【図5】従来のMQW半導体レーザの発振時のホール密度分布の説明図である。

【図6】従来のMQW半導体レーザの発振時の電子密度分布の説明図である。

【図7】従来のMQW半導体レーザの多重量子井戸中の光学利得分布の説明図である。

【図8】従来のMQW半導体レーザの光出力-電流特性の説明図である。

## 【符号の説明】

1 多重量子井戸活性層

2 井戸層

3 間隔層

4 p側光ガイド層

5 n側光ガイド層

11 n型SiC基板

12 n型AlGaNバッファ層

13 n型GaN中間層

14 n型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nクラッド層

15 アンドープGaN光ガイド層

16 MQW活性層

17 アンドープIn<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nウエル層18 p'型In<sub>0.05</sub>Ga<sub>0.95</sub>Nバリア層

19 p'型GaN光ガイド層

20 p型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nクラッド層

21 p型GaNコンタクト層

22 Ni電極

23 Ni電極

24 p'型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nエレクトロンプロック層

31 n型SiC基板

32 n型AlGaNバッファ層

33 n型GaN中間層

34 n型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nクラッド層

35 アンドープGaN光ガイド層

36 MQW活性層

37 アンドープIn<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nウエル層

38 アンドープGaN光ガイド層

40 p型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nクラッド層

41 p型GaNコンタクト層

42 Ni電極

43 Ni電極

【図1】

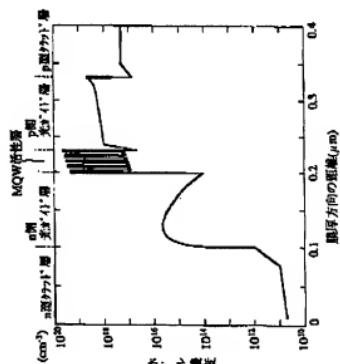
本発明の原理的構成の説明図

【図5】

従来のMQW半導体レーザの発振時のホール密度分布の説明図

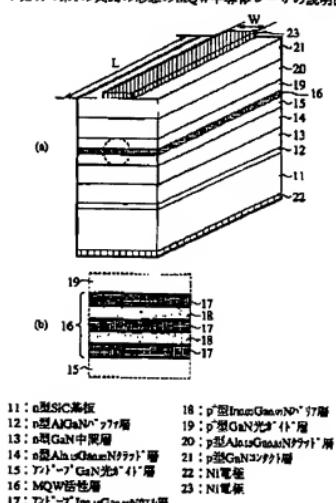


- 1: 多重量子井戸活性層
- 2: 井戸層
- 3: 間隔層
- 4: p側光ガイド層
- 5: n側光ガイド層



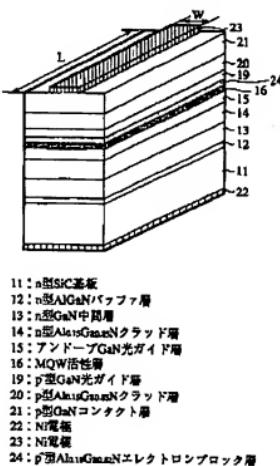
【図2】

本発明の第1の実施の形態のMQW半導体レーザの説明図

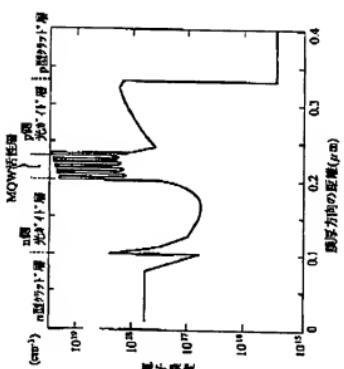


【図3】

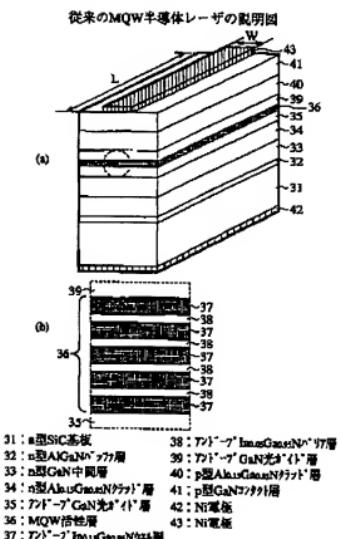
本発明の第2の実施の形態のMQW半導体レーザの斜視図



【図6】

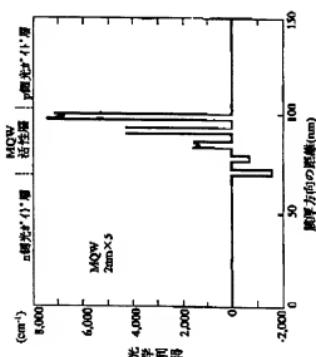
従来のMQW半導体レーザの  
発振時の電子密度分布の説明図

【図4】



【図7】

従来のMQW半導体レーザの  
多重量子井戸中の光学利得分布の説明図



【図8】

従来のMQW半導体レーザの  
光出力-電流特性の説明図

